1/1



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number: 06235061

(43)Date of publication of application: 23.08.1994

(51)Int.Cl.

C23C 14/24 C23C 14/56

(21)Application number: 05021561

(71)Applicant:

ISHIKAWAJIMA HARIMA HEAVY IND

CO LTD

(22)Date of filing: 10.02.1993

(72)Inventor:

NEHASHI KIYOSHI

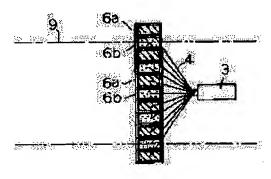
(54) CONTINUOUS VACUUM DEPOSITION DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To maintain a specified vapor deposition speed ratio of an alloy and to provide uniform films without being affected by the height from crucibles by specifying the arrangement of the plural crucibles contg. plural materials for vapor deposition with this device including an ion plating device.

CONSTITUTION: The continuous vacuum deposition device having a continuously traveling band-shaped sheet substrate 9

CONSTITUTION: The continuous vacuum deposition device having a continuously traveling band-shaped sheet substrate 9 and the plural crucibles 6a, 6b is used. Electron beams 4 are radiated by an electron gun 3 to evaporate or sublimate, for example, two kinds of the materials for vapor deposition in the crucibles 6a, 6b and to solidify the alloy flow on the surface of the substrate 9, by which the alloy film is formed. The crucibles 6a, 6b are arranged, for example, alternately in the direction intersecting with the traveling direction of the substrate 9 so as to coexist on approximately the same one line. The respective crucibles 6a, 6b are dividedly irradiated with the electron beams 4 from the electron gun 3. The power of the electron beams to be charged to the crucibles is regulated in this irradiation in



such a manner that the evaporation amts. from the crucibles 6a, 6b and the vapor deposition speeds in the transverse direction of the traveling substrate 9 are uniformly distributed.

Searching PAJ

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998 Japanese Patent Office







(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-235061

(43)公開日 平成6年(1994)8月23日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

C 2 3 C 14/24 14/56 9271-4K

8520-4K

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特顧平5-21561

(22)出顧日

平成5年(1993)2月10日

(71)出願人 000000099

石川島播磨重工業株式会社

東京都千代田区大手町2丁目2番1号

(72)発明者 根橋 清

神奈川県横浜市磯子区新中原町1番地 石

川島播磨重工業株式会社横浜第二工場内

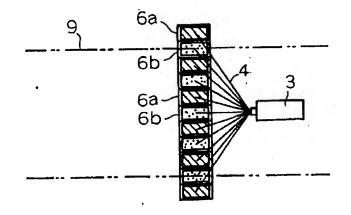
(74)代理人 弁理士 堀田 実 (外2名)

(54)【発明の名称】 連続真空蒸着装置

(57)【要約】

(目的) 合金蒸着領域のいずれの位置においても合金 の蒸着速度比率が一定であり、厚さ方向にも均一の合金 皮膜を走行基板上に得ることができ、ルツボからの高さ に影響されることなく、均一の合金皮膜を走行基板上に 得ることができる連続真空蒸着装置を提供する。

【構成】 真空中で複数のルツポ6a、6bから異なる 複数の蒸着材料A、Bを蒸発又は昇華させて連続的に供 給される走行基板9の表面に合金膜を形成させる連続真 空蒸着装置において、複数の蒸発材料を収納した複数の ルツポが、走行基板の走行方向と交差する方向にほぼ同 一線上に、混在するように配置されている。



Copress Mais EL039752006 US

【特許請求の範囲】

【請求項!】 真空中で複数のルツボから異なる複数の 蒸着材料を蒸発又は昇華させ、連続的に供給される走行 基板の表面に合金膜を形成させる連続真空蒸着装置にお いて、

複数の蒸着材料を収納した前記複数のルツポは、走行基 板の走行方向と交差する方向にほぼ同一線上に、混在す るように配置される、ことを特徴とする連続真空蒸着装 僧.

【請求項2】 前記複数のルツポは2種の蒸着材料を収 10 納し、走行基板の走行方向とほぼ直交する同一線上に配 置され、かつ、 2 種の蒸着材料を収納するルツボが混在 するように配置される、ことを特徴とする請求項1に記 載の連続真空蒸着装置。

【請求項3】 電子銃からの電子ピームが各ルツポに扱 り分けて照射され、かつ走行基板の幅方向の蒸着速度が 均一に分布するように、各ルツボに投入する電子ビーム のパワーが調整される、ことを特徴とする請求項1に記 載の連続真空蒸着装置。

【発明の詳細な説明】

100011

【 産 業 上 の 利 用 分 野 】 本 発 明 は 、 イ オ ン ブ レ ー テ ィ ン グ 装置を含む真空蒸着装置に係わり、更に詳しくは、連続 真空処理設備において蒸着材料を蒸発又は昇華させて被 処理材に合金を蒸着させる装置に関する。

[0002]

【従来の技術】真空蒸着 (vacuum deposition)は、真空 中で材料を加熱して蒸発又は昇華させ、蒸着材料を基板 (被処理材)の表面に凝固させて皮膜を作る成膜プロセ スである。かかる成膜プロセスにおいて蒸着材料を加熱 するために例えば電子ピームを用い薄板状の連続した走 行基板に金属を蒸着させる連続真空蒸着装置が従来から 知られている。この連続真空蒸着装置は、2種以上の金 属の合金皮膜が容易にでき、かつ付着速度が大きい等の 多くの長所を有している。2種以上の合金皮膜を形成す る従来の連続真空蒸着装置は、例えば特開平4-218 660号公報、及び特別平4-235272号公報に開 示されている。かかる従来の連続真空蒸着装置では、2 種の蒸着材料を収納した2つのルツボが走行基板の走行 方向に隣接して配置されていた。すなわち、従来の連続 真空蒸着装置では、図6及び図7に示すように、連続し て走行する薄板帯状の走行基板9と、電子ビーム4を放 射する電子銃3と、蒸着材料A、Bを収容するルツボ6 a、 6 b と、走行基板及びルツボを内蔵し 1 0 ⁻³~ 1 0 ⁻⁵torrに真空排気2された真空チャンパーlとを備 え、電子銃3により電子ピームを放射し、図示しない磁 界により電子ピーム4の方向を曲げてルツポ6a、6b 内の蒸着材料A、Bを加熱して蒸発又は昇華させ、蒸発 流7a、7bからなる合金流8を走行基板9の表面に凝 固させて合金皮膜を作るようになっている。また走行甚 50 板はガイドローラ10を介して水平に走行する。かかる 連続真空蒸着装置により2種金属の合金皮膜を走行基板 状に形成することができる。

100031

【発明が解決しようとする課題】蒸着材料A、Bを収納 したルツポ6 a、6 bを走行基板9の走行方向に密接さ せて配置してもルツポ6a、6bの中心間距離は相当大 きくなってしまう。例えば、通常のルツポ6a、6bの 中心間距離は200~900mm程度となる。すなわ ち、ルツボの壁厚は片側で20~70mmあり(蒸着材 料やルツボ材料、使用温度により異なる)、内のり幅が 100mmの小さいルツボであってもルツボの中心間距 離は140~240mmとなり、ルツボの内のり幅が2 0 0 m m 以上の通常のルツボでは、ルツボの中心間距離 は更に大きくなってしまう問題がある。従って、例え ば、蒸着材料A、Bの蒸発速度の比率が各ルツボの中心 上で2:1になるように(図8参照)各ルツボの蒸発量 を制御しても、このルツボの中心間距離が大きいため、 走行基板9上の合金蒸着領域での蒸着速度の比率が走行 基板の位置により逐次異なってしまう問題点があった。 すなわち、図8において、ルツポ6aの中心ではAの森 発速度とBの蒸発速度の比率がほぼ2:1であるが、そ の他の合金蒸着領域ではこの比率が異なっており、その 結果、厚さ方向に異なる合金皮膜が走行基板上に形成さ れてしまう問題点がある。従って、走行基板9上に成膜 された膜質が走行基板の蒸着された位置により異なり、 必要な品質を十分満足できない問題点があった。また、 図8で示したように所望の合金比率が得られる領域は合 金蒸着領域の一部だけであるため、図9に示すように、 ルツポ6a、6bからの高さhを小さくすると(例えば 図で h 3)、 走行基板への蒸着歩留りは良い (走行基板 9 の端部から外側に漏れる量が少ない)が、合金蒸着領域 が狭くなり、蒸着速度が速くなり、膜質が悪化する問題 点があった。そのため、従来の連続真空蒸着装置では、 図にh1 或いはh2 で示すように、走行基板の高さhを 大きくせざるを得なかったが、この結果蒸着歩留りが悪 化する (走行基板9の端部から外側に漏れる量が多い) 問題点があった。

【0004】本発明は上記種々の問題点を解決するため に創案されたものである。すなわち、本発明は、合金蒸 着領域のいずれの位置においても合金の蒸着速度比率が 一定であり、厚さ方向にも均一の合金皮膜を走行基板上 に得ることができる連続真空蒸着装置を提供することを 目的とする。更に本発明は、ルツボからの走行基板の高 さに影響されることなく、均一の合金皮膜を走行基板上 に得ることができる連続真空蒸着装置を提供することを 目的とする。

[00051

40

【課題を解決するための手段】本発明によれば、真空中 で複数のルツボから異なる複数の蒸着材料を蒸発又は昇

[0006]

【作用】上記、本発明の構成によれば、複数の蒸着材料 を収納した複数のルツポが、走行基板の走行方向と交差 する方向にほぼ同一線上に、混在するように配置される ので、走行基板の走行方向のルツボの中心位置が実質的 に一致し、従来のようにルツボの中心間距離が大きくな らない。従って、ルツボの中心で蒸発速度の比率を一定 に制御すれば、合金蒸着領域の全体にわたってこの比率 が維持され、その結果、厚さ方向にも均一の合金皮膜を 走行基板上に形成することができる。すなわち、走行基 板上に成膜された膜質は走行基板の蒸着された位置にか かわらず均一であり、良質の蒸着皮膜を得ることができ る。また、所望の合金比率が得られる領域が蒸着領域の 全域であるため、ルツボからの走行基板の高さhを小さ くしても、合金蒸着領域は広く、従って蒸着速度を遅く でき、膜質が悪化しない。これにより、ルツポからの走 行基板の高さに影響されることなく、均一の合金皮膜を 30 走行基板上に得ることができる。

[0007]

【実施例】以下に本発明の好ましい実施例を図面を参照 して説明する。図1は、本発明による連続真空蒸着装置 の全体構成図であり、図2は図1のC-C線における平 面図である。図1及び図2において、連続真空蒸着装置 は、連続して走行する薄板帯状の走行基板9と、電子ピ ーム4を放射する電子銃3と、蒸着材料A、Bを収容す るルツボ6a、6bと、走行基板及びルツボを内蔵し1 0⁻³~10⁻⁵torrに真空排気2された真空チャンパ 40 - 1 とを備え、電子銃 3 により電子ピーム 4 を放射し、 図示しない磁界により電子ピーム4の方向を曲げてルツ ポ6a、6b内の蒸着材料A、Bを加熱して蒸発又は昇 華させ、蒸発流7a、7bからなる合金流8を走行基板 9 の表面に凝固させて合金皮膜を作るようになってい る。また走行基板はガイドローラ10を介して水平に走 行する。かかる連続真空蒸着装置により2種金属の合金 皮膜を走行基板状に形成することができる。この構成 は、従来の連続真空蒸着装置と同様である。

【0008】本発明の連続真空蒸着装置において、複数 50

の蒸着材料を収納した前記複数のルツボ6a、6bは、 走行某板 9 の走行方向と交差する方向にほぼ同一線上 に、混在するように配置されている。すなわち、図1及 び図2において、複数のルツボ6a、6bが2種の蒸着 材料A、Bを収納しており、この複数のルツポ6a、6 bは走行基板9の走行方向とほぼ直交する同一線上に配 置され、かつ、2種の蒸着材料A、Bを収納するルツボ 6a、6bは交互に配置されている。なお、走行基板 9 の走行方向に直角な方向の同一線上に蒸着材料AとBの ルツポを交互に並べるのは、実用上A、Bの蒸着材料に よって走行基板上の蒸着速度(例えばα/sec)の分 布が均一になるようにするためである。従って、A、 B、A、B、A、Bの順序でなくても良く、例えばAの ルツポ6aの幅がなんらかの理由で小さい場合は、A、 A、B、A、A、B、A、A、B・・・の順序でも良 い。また、図1及び図2の例では蒸着材料はA、Bの2 種であるが、3種以上の場合でも同様である。合金化す る材料が3種類の場合は、例えばA、B、C、A、B、 C、A、B、C、・・・の順序に互い違いに配置するの がよい。更に、ルツボを並べる方向は走行基板9の走行 方向と90°(直交)に限定されず、斜めであっても良

【0009】 電子銃3からの電子ピーム4は各ルツポ6 a、6bに振り分けて照射する。この照射は、各ルツボ 6 a、 6 b からの蒸着量、及び走行基板 9 の幅方向の蒸 着速度が均一に分布するように、各ルツボに投入する電 子ピームのパワーを調整する。なお、実際には電圧が一 定であるので、電流値、更に詳しくは各ピーム照射点の 電子ビームの滞在時間を調整する。なお、電子ビームに よる加熱ではなく、抵抗加熱や誘導加熱による場合はル ツボへのインブットパワー(入力電力)を調整する。 【0010】図3は本発明の連続真空蒸着装置による走 行基板上の蒸着速度分布を示す図である。ルツボ6a、 6 b の中心が一致するため、蒸着材料 A 、 B の蒸発速度 の比率がルツボの中心上で2:1になるように各ルツボ の蒸発量を制御すれば、走行基板9上の合金蒸着領域で の蒸着速度の比率は走行基板の位置にかかわらず一定と なる。すなわち、図3において、ルツポ6a、6bの中 心でAの蒸発速度とBの蒸発速度の比率がほぼ2:1で あり、その他の合金蒸着領域でもこの比率が保持されて いる。従って、厚さ方向にも均一の合金皮膜を走行基板 上に形成することができる。また、走行基板9上に成膜 された膜質が走行基板の蒸着された位置にかかわらずー 定であり、必要な品質を十分満足することができる。 【0011】図4は、本発明による連続真空蒸着装置に

おける電子ピームによる蒸発の強さ(A)と、この場合

の蒸着レイト(速度)(B)を示しており、図5は従来

の連続真空蒸着装置における同様の図を示している。従

来の図5において、例えばA材料が収納されている80 0mm幅のルツポに(A)で示したパターン(照射位置

10

【0012】 なお、イオンプレーティングの場合(図示せず)は、図1における蒸発流7a、7bにイオン化プローブ法、高周波法、等により電子を衝突させイオン化させて一部の蒸発流7a、7bをイオン化された蒸発流7a、7bを引き寄せて成膜させる。また蒸発流7a、7bの近傍に反応性ガス(例えば窒素(N2)や酸素(O2)を導入し、併せてイオン化させ、蒸発流7a、7bのようでは扱えなかった窒化物、炭化物、酸化物などの蒸着も可能である。

【0013】上述したように、本発明によれば、複数の 蒸着材料を収納した複数のルツボが、走行基板の走行方 向と交差する方向にほぼ同一線上に、混在するように配 置されるので、走行基板の走行方向のルツボの中心位置 30 が実質的に一致し、従来のようにルツボの中心間距離が 大きくならない。従って、ルツボの中心で蒸発速度の比 率を一定に制御すれば、合金蒸着領域の全体にわたって この比率が維持され、その結果、厚さ方向にも均一の合 金皮膜を走行基板上に形成することができる。すなわ ち、走行基板上に成膜された膜質は走行基板の蒸着され た位置にかかわらず均一であり、良質の蒸着皮膜を得る ことができる。また、所望の合金比率が得られる領域が 蒸着領域の全域であるため、ルツポからの走行基板の高 さhを小さくしても、合金蒸着領域は広く、蒸着速度を 遅くでき、膜質が悪化しない。従って、ルツボからの走 行基板の高さに影響されることなく、均一の合金皮膜を 走行基板上に得ることができる。

[0014]

【発明の効果】上述したように、本発明によれば、走行基板上の合金蒸着領域におけるA材料とB材料の蒸着速度の比率をいずれの場所においても同一とすることができるため、膜質が均一な蒸着処理基板(例えば鋼板)が得られ実用に足ることができる。また、ルツボを走行基板9の走行方向に複数(2個)並べる必要がないので、

· その分真空チャンパー1のサイズを小さくできる。この ことは、真空チャンパーの真空排気ポンプも小さくする ことができ、設備費の低減、ランニングコストの低減、 ひいては蒸着処理品のコストを低減できる。更に、走行 基板上の合金化比率は走行方向のいずれの場合において も同比率となるため、合金蒸着領域を広く取れる。この ことは生産性アップにつながり、蒸着処理のコストを更 に下げることができる。更に重要なことは、合金の比率 が極めて厳しい(許容される合金化の比率が極めて狭い 範囲に限定される)場合でも、本発明により広い合金蒸 着領域で蒸着が可能となる。これにより、合金化比率の 許容範囲が狭いため従来実質上不可能であった合金も成 膜することができる。更に、膜質は一般に蒸着速度が早 くなれば悪くなるが合金蒸着領域が広いため、従来と同 じ走行基板9の走行速度でも蒸着速度(成膜速度)を遅 くすることができ、膜質を大幅に向上させることができ る。更に、合金蒸着領域が従来例より広くなるため、従 来と同一蒸着速度(成膜速度)が必要な場合であっても ルツポ~走行基板間の距離を小さくでき、これによって 蒸着歩留りを向上でき、生産コストを下げることができ る。走行基板9の端部(ルツボの両端部)より外側への 蒸発流分の無効蒸着量はルツポ~走行基板間距離が短い 方が良い。更に、走行基板9の走行方向の無効蒸着量も 合金蒸着領域が広くなった分減り、生産コストの低下、 チャンパー壁や遮蔽板11に付着した蒸着物の除去作業 の重労働も軽減される。

【0015】従って要約すれば、本発明による連続真空 蒸着装置により、合金蒸着領域のいずれの位置において も合金の蒸着速度比率が一定であり、厚さ方向にも均一 の合金皮膜を走行基板上に得ることができ、かつ、ルツ ボからの走行基板の高さに影響されることなく、均一の 合金皮膜を走行基板上に得ることができる。

【図面の簡単な説明】

50

【図1】 本発明による連続真空蒸着装置の全体構成図である。

【図2】 図1のC-C線における平面図である。

【図3】 本発明の連続真空蒸着装置における走行基板の位置と蒸着速度との間係を示す図である。

【図4】 本発明による連続真空蒸着装置における電子 ピームによる蒸発の強さ(A)と、この場合の鋼板上の 蒸着レイト(速度)(B)とを示す図である。

【図 5】 従来の連続真空蒸着装置における図 4 と同様の図である。

【図 6】 従来の連続真空蒸着装置の全体構成図である。

【図7】 図6のD-D線における平面図である。

【図8】 従来の連続真空蒸着装置における走行基板の位置と蒸着速度との関係を示す図である。

【図9】 ルツボと走行基板間の距離が静特性に及ぼす 影響を示す図である。 7

(符号の説明)

1 真空チャンパー

2 真空排気

3 電子銃

4 電子ピーム

6 ルツボ

6 a 蒸着材料Aを収納するルツボ

6 b 蒸着材料Bを収納するルツボ

7 a 蒸着材料Aの蒸発流

(図1)

7b 蒸着材料Bの蒸発流

8 蒸着材料AとBの各々の蒸発流が混合している領域

9 走行基板

10 ガイドローラ

11 遮蔽板

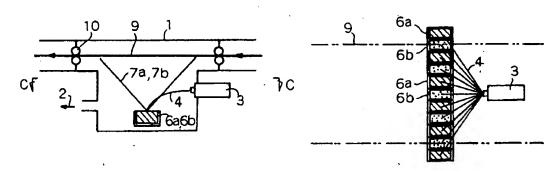
12 走行基板レベル上の蒸着速度分布

12 a 走行基板レベル上の蒸着材料Aの蒸着速度分布

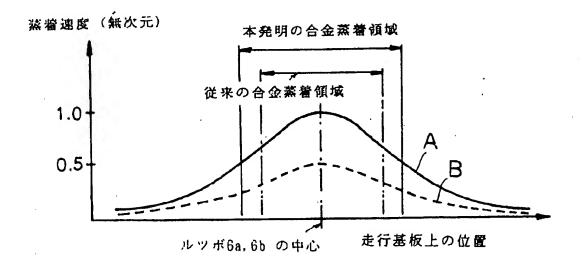
12 b 走行基板レベル上の蒸着材料Bの蒸着速度分布

A、B 蒸着材料

【図2】

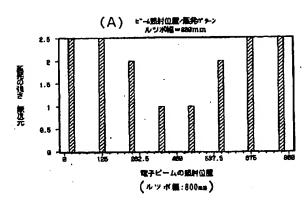


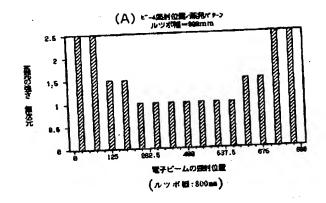
【図3】.

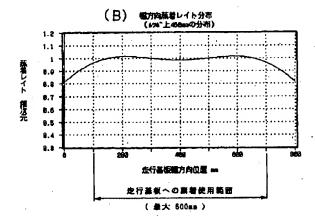


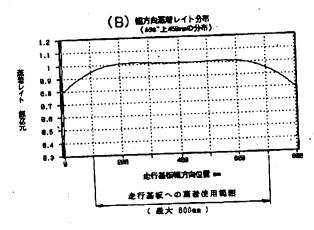
[图4]





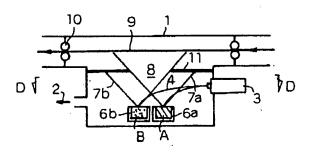


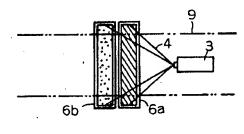




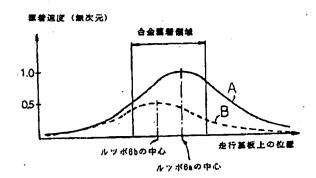
(図6)

[图7]

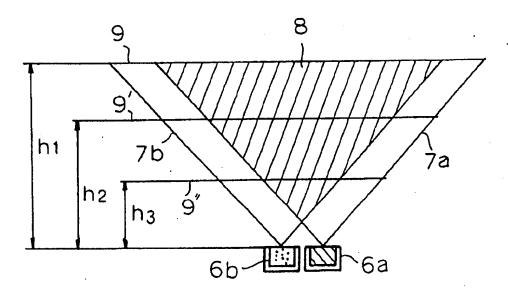




[図8]



[図9]



走行基板高さ	合金蒸 着 領域	蒸着速度	膜質	走行甚板への蒸着歩留り
h 1	広い	遅い	良い	悪い
h 2	中間	中間	中間	中間
h 3	狭い	速い	悪い	良い